

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(10) 国際公開番号

WO 2012/023373 A1

PCT

(43) 国際公開日
2012年2月23日(23.02.2012)

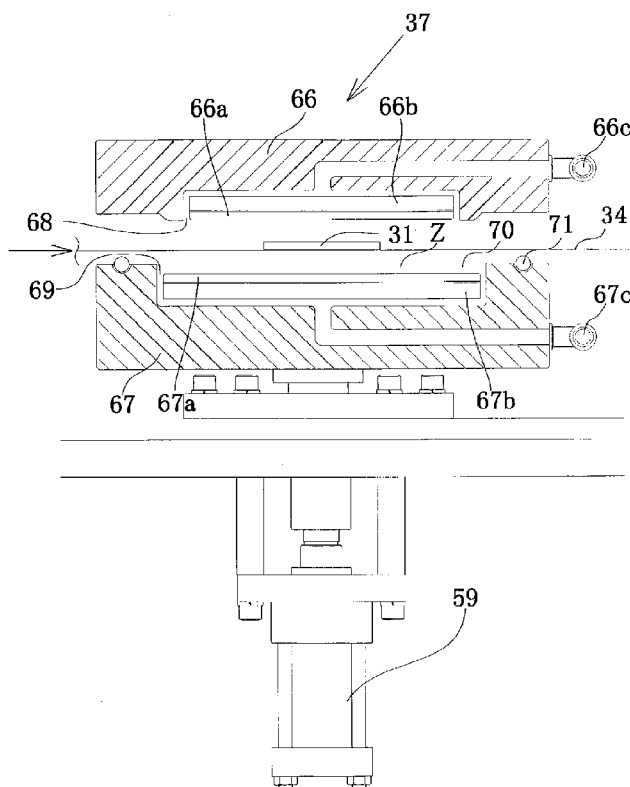
- (51) 国際特許分類:
B29C 63/02 (2006.01) B29C 65/78 (2006.01)
B29C 43/18 (2006.01) B29L 9/00 (2006.01)
B29C 43/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/066304
- (22) 国際出願日: 2011年7月19日(19.07.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-185418 2010年8月20日(20.08.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ニチゴー・モートン株式会社(Nichigo-Morton Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒5310076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 Osaka (JP). 信越化学工業株式会社(Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 安本 良一(YASUMOTO Ryoichi) [JP/JP]; 〒5310076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 ニチゴー・モートン株式会社内 Osaka (JP). 岩田 和敏(IWATA Kazutoshi) [JP/JP]; 〒5310076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 ニチゴー・モートン株式会社内 Osaka (JP). 児玉 欣也(KODAMA Kinya) [JP/JP]; 〒3790224 群馬県安中市松井田町人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコン電子材料技術研究所内 Gunma (JP). グリゴリー ベイシン(Grigoriy Basin) [US/US]; 94121 カリフォルニア州サンフランシスコ トウエンティフォース アベニュー 526 California (US).
- (74) 代理人: 西藤 征彦, 外(SAITOH Yukihiko et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町2丁目2番7号 シティ・コーポ南森町802 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

[続葉有]

(54) Title: STACKING APPARATUS

(54) 発明の名称: 積層装置

[図19]



(57) Abstract: Provided is a stacking apparatus which deposits a film-shaped resin on a base material in such a way that the film-shaped resin completely follows the protrusions and depressions of the base material, and which more stringently maintains the uniformity of the thickness of the deposited film-shaped resin. For this purpose, the stacking apparatus is provided with a stacking mechanism (E1) which comprises: a closed-space forming means that is capable of accommodating a temporary stack (PL1) (31); and a pressure stacking means (P1) that applies pressure to the temporary stack (PL1) (31) by means of a non-contact method in a closed space (Z) formed by the closed-space forming means, and forms a stack from the temporary stack (PL1) (31).

(57) 要約: フィルム状樹脂を基材の凹凸に完全に追従させ、しかも、追従させたフィルム状樹脂の膜厚をより厳密なレベルで均一にする積層装置を提供するため、図19に示すように、仮積層体(PL1)(31)を収容可能な密閉空間形成手段と、上記密閉空間形成手段によって形成された密閉空間Zにおいて、非接触状態で仮積層体(PL1)(31)を加圧し、仮積層体(PL1)(31)から本積層体を形成する加圧積層手段(P1)と有する積層機構(E1)を備えるようにした。